

Содержание

• Электроиные свойства полупроводников

Сардарлы Р.М., Абдуллаев А.П., Алиева Н.А., Салманов Ф.Т., Юсифов М.Ю., Оруджева А.А.
Суперионная проводимость твердых растворов $(\text{TiGaSe}_2)_{1-x}(\text{TlInS}_2)_x$ 1111

• Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Мездрогина М.М., Виноградов А.Я., Кожанова Ю.В.
Формирование спектров люминесценции, интенсивность излучения в УФ и видимой областях структур $n\text{-ZnO}/p\text{-GaN}$, $n\text{-ZnO}/p\text{-ZnO}$ при нанесении пленок ZnO методом высокочастотного магнетронного распыления . . . 1115

Свитенков И.Е., Павловский В.Н., Луценко Е.В., Яблонский Г.П., Ширипов В.Я., Хохлов Е.А., Мудрый А.В., Живулько В.Д., Бородавченко О.М., Якушев М.В.
Люминесценция и стимулированное излучение поликристаллических пленок $\text{Cu}(\text{In,Ga})\text{Se}_2$, осажденных методом магнетронного напыления 1120

• Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Минтаиров М.А., Евстропов В.В., Минтаиров С.А., Салий Р.А., Шварц М.З., Калюжный Н.А.
Рекомбинация в $\text{GaAs } p\text{-}i\text{-}n$ -структурах с InGaAs квантово-размерными объектами: моделирование и закономерности 1126

Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Надточий А.М., Максимов М.В., Неведомский В.Н., Сокура Л.А., Рувимов С.С., Шварц М.З., Жуков А.Е.
Многослойные InGaAs -гетероструктуры „квантовая ямочки“ в фотопреобразователях на основе GaAs 1131

• Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Ундалов Ю.К., Теруков Е.И., Трапезникова И.Н.
Изучение влияния временных характеристик модулированной ДС-плазмы с $(\text{SiH}_4\text{-Ar-O}_2)$ -газовой фазой на рост ncI-Si в матрице $a\text{-SiO}_x\text{:H}$ ($\text{CO}_2 = 15.5$ мол%) 1137

• Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Белопицкий А.В., Нестоклон М.О., Ясевич И.Н.
Моделирование уровней размерного квантования Si-нанокристаллов в матрице SiO_2 : подбор параметров эмпирического метода сильной связи 1145

• Физика полупроводниковых приборов

Торхов Н.А.
Влияние электростатического поля периферии на вентильный фотоэффект в контактах металл-полупроводник с барьером Шоттки 1150

Волков В.В., Коган Л.М., Туркин А.Н., Юнович А.Э.
Спектры люминесценции мощных светодиодов на основе нитрида галлия в ультрафиолетовой и фиолетовой областях спектра 1172

Макаров А.А., Тягинов С.Э., Kaczer B., Jech M., Chasin A., Grill A., Hellings G., Векслер М.И., Linten D., Grasser T.
Анализ особенностей деградации, вызываемой горячими носителями, в транзисторах с каналом в форме плавника . . . 1177

Гребенщикова Е.А., Салихов Х.М., Сидоров В.Г., Шутаев В.А., Яковлев Ю.П.
Определение концентрации водорода по фотоэкс МДП структур Pd -оксид- InP 1183

Иванов П.А., Потапов А.С., Кудояров М.Ф., Самсонова Т.П.
Влияние низкодозного протонного облучения на характеристики инжекционных диодов на основе 4H-SiC 1187

Максимов М.В., Надточий А.М., Шерняков Ю.М., Паюсов А.С., Васильев А.П., Устинов В.М., Серин А.А., Гордеев Н.Ю., Жуков А.Е.
Влияние конструкции эпитаксиальной структуры и параметров роста на характеристики метаморфных лазеров оптического диапазона 1.46 мкм на основе квантовых точек на полужках GaAs 1191

Немов С.А., Андреева В.Д., Улашкевич Ю.В., Поволоцкий А.В., Аллаххад А.А.
Особенности спектров ИК отражения и комбинационного рассеяния кристаллов $\text{Sb}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$ 1197

• Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Боднар И.В., Детков С.А., Касюк Ю.В., Федотова Ю.А.
Выращивание монокристаллов $\text{FeIn}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ и исследование их свойств 1203

Рягузов А.П., Немкаева Р.Р., Гусейнов Н.Р.
Влияние условий синтеза и наночастиц олова на структуру и свойства композитных тонких пленок $a\text{-C:H(Sn)}$ 1207

Маскаева Л.Н., Федорова Е.А., Марков В.Ф., Кузнецов М.В., Липина О.А., Поздин А.В.
Тонкие пленки селенида меди(1): состав, морфология, структура, оптические свойства 1213

Попов В.П., Антонов В.А., Вдовин В.И.
Положительный заряд в КНС-гетероструктурах с межслойным оксидом кремния 1220

Марков Л.К., Павлюченко А.С., Смирнова И.П., Павлов С.И.

Исследование профиля эффективного показателя преломления в самоорганизующихся наноструктурированных пленках ГТО 1228

Лундин В.В., Цацульников А.Ф., Родин С.Н., Сахаров А.В., Усов С.О., Митрофанов М.И., Левицкий Я.В., Евтихий В.П.

Селективный эпитаксиальный рост III–N-структур с использованием ионной нанолитографии 1237

Карлина Л.Б., Власов А.С., Сошников И.П., Смирнова И.П., Бер Б.Я., Смирнов А.Б.

Рост наноструктур в системе Ga(In)AsP–GaAs в квазиравновесных условиях 1244

● **Персоналии**

Памяти Константина Дамдиновича Цэндина (15.09.1942–04.04.2018) 1250